

※課題番号 : F-12-KT-0131  
※支援課題名 (日本語) : MOSFET の絶縁膜厚とドレイン電流の関係調査  
※Program Title (in English) : Research of correlation between thickness of gate oxide and MOSFET drain current  
※利用者名 (日本語) : 中田 嘉昭  
※Username (in English) : Yoshiaki Nakata  
※所属名 (日本語) : 株式会社堀場製作所  
※Affiliation (in English) : HORIBA, Ltd.

※概要 (Summary) :

同じ構造でありながら電気特性 (ドレイン電流量) が違う MOSFET のゲート絶縁膜厚を調べ、膜厚と電気特性の相関を調査する。 関連特許 (Patent) : なし

※実験 (Experimental) :

FIB (B6) でゲート部断面を作製し、FIB 装置に内蔵されている電子顕微鏡で断面を観察しようとした。

※結果と考察 (Results and Discussion) :

装置の日程が合わず、実験はできなかった。

※その他・特記事項 (Others) :

装置使用の日程調整をする中で、MOSFET の電気特性に違いが出る原因を、別の手法で特定することができ、断面観察の必要は無くなった。

FIB のオペトレは完了したので、今後の様々な研究にナノハブを活用する予定。

共同研究者等 (Coauthor) :

なし

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

予定なし